PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-177842

(43) Date of publication of application: 27.06.2000

(51)Int.Cl.

B65G 49/06 B01J 3/02 H01L 21/205 H01L 21/68

(21)Application number: 10-351364

(71)Applicant: MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(22)Date of filing:

10.12.1998

(72)Inventor: SASAGAWA EISHIRO

KANZAKI JUNICHI

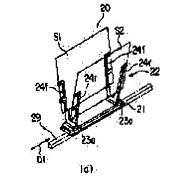
UENO MOICHI

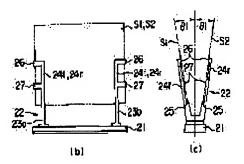
KONDOU TAKANOBU NISHIMURA TOSHIMICHI

(54) CARRYING DEVICE AND VACUUM PROCESSING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a carrying device capable of moving a substrate to be processed without a tray holder for a vacuum processing system. SOLUTION: A carrying device 20 has a carriage 21 for traveling in a system and a support mechanism 22 provided on the carriage 21 for supporting two glass substrates S1, S2 simultaneously. The support mechanism 22 supports the two glass substrates S1, S2 such that the two glass substrates S1, S2 are tilted at an angle θ 1 of about 10° in the opposite directions from the perpendicular line at the center axis of the carriage 21 along carrying direction D1. The support mechanism 22 has parts supporting the back of the substrates S1, S2 at positions above the center of gravity of each substrate





S1, S2. The substrates S1, S2 are held by their own weights on the support mechanism 22 in stable state.

Searching PAJ Page 2 of 2

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.08.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2000-177842 (P2000-177842A)

(43)公開日 平成12年6月27日(2000.6.27)

(51) Int.CL'		織別記号	FI			チーマコード(参考)
B65G	49/06		B65G	49/08	Z	5 F 0 3 1
B01J	3/02		B01J	3/02	N	5 F 0 4 5
H01L	21/205		HOIL	21/205		
	21/68			21/68	Α	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

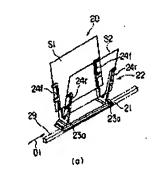
	•		
(21)出顯番号	特顧平10-351364	(71)出項人	000006208 三菱重工聚株式会社
(22)出題日	平成10年12月10日(1998.12.10)		東京都千代田区丸の内二丁目5番1号
		(72) 発明者	惟川 英四郎
			長崎県長崎市館の浦町1番1号 三菱重工
			業株式会社長崎造船所内
		(72) 発明者	挿前 潤一
			長崎県長崎市路の浦町1番1号 三菱重工
	•		桑株式会社長崎造船所內
		(74)代理人	100058479
			弁理士 鈴江 武彦 (外4名)
			最終質に続く

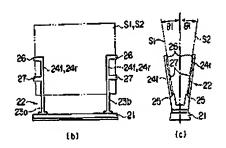
(54) 【発明の名称】 搬送装置及び真空処理システム

(57)【要約】

【課題】真空処理システムにおいて、トレイホルダを使 用することなく彼処理基板を移動できる鍛送装置を提供 する。

【解決手段】搬送装置20は、システム内を定行するた めの台車21と、2枚のガラス基板S1、S2を同時に 支持するため、台車21上に配設された支持機構22 と、を有する。支持機構22は、鍛送方向D1に沿った 台車21の中心軸を挟んで、2枚の基板S1、S2が垂 線に対して約10°の角度81で互いに反対側に傾斜す るように、2枚の基板S1、S2を支持する。支持機構 22は、各基板S1、S2の重心より上でその裏面を接 触支持する部分を有する。基板S1. S2は、自重によ り安定した状態で支持機構22上に保持される。





(2)

特闘2000-177842

【特許請求の範囲】

【請求項1】多角形板状の核処理基板を処理するための 真空処理システム内において前記被処理基板を搬送する ための鍛送装置であって.

1

前記システム内を走行するための台車と、

前記候処理基板を支持するため、前記台車上に配設され た支持機構と、を具備し、

前記支持機構は、前記敘処理基板が垂線に対して?* 乃 至12 の角度で傾斜するように、前記彼処理墓板を支 待することと.

前記支持機構は、前記彼処理基板の底端面に接触するた めの底接触面と、前記彼処理基板の裏面に接触するため の第1及び第2裏接触面とを有することと、

前記第1及び第2裏接触面は、前記被処理基板の搬送方 向において互いに独立した第1及び第2支柱に支持され た第1及び第2パッド上に夫々形成されることと、

前記第1及び第2裏接触面は、前記搬送方向における前 記被処理基板の両端部に沿って夫々配置されることと、 前記第1及び第2裏接触面は、前記被処理基板の重心よ り上で前記被処理基板の前記裏面と接触する部分を失っ 20 【0001】 有することと、を特徴とする鍛送装置。

【請求項2】多角形板状の第1及び第2彼処理基板を処 **運するための真空処理システム内において前記第1及び** 第2被処理基板を同時に搬送するための鍛送装置であっ

前記システム内を定行するための台車と、

前記第1及び第2彼処理基板を同時に支持するため、前 記台車上に配設された支持機構と、を具備し、

前記支持機構は、前記第1及び第2被処理基板が垂線に 対して7. 乃至12. の角度で互いに反対側に傾斜する 30 よろに、前記第1及び第2被処理基板を支持すること

前記支持機構は、前記第1被処理基板の底端面に接触す るための第1底接触面と、前記第1被処理基板の裏面に 接触するための第1及び第2裏接触面とを有すると共 に、前記第2被処理基板の底端面に接触するための第2 底接触面と、前記第2級処理基板の裏面に接触するため の第3及び第4裏接触面とを有することと、

前記第1及び第2裏接触面は、前記第1及び第2被処理 柱に支持された第1及び第2パッド上に失っ形成される と共に、前記第3及び第4裏接触面は、前記銀送方向に おいて互いに独立した第3及び第4支柱に支持された第 3及び第4パッド上に矢々形成されることと、

前記第1及び第2裏接触面は、前記級送方向における前 記第1級処理基板の両端部に沿って夫々配置されると共 に、前記第3及び第4裏接触面は、前記銀送方向におけ る前記第2被処理基板の両端部に沿って失々配置される ことと、

心より上で前記第1被処理基板の前記裏面と接触する部 分を夫々有すると共に、前記第3及び第4裏接触面は、 前記第2被処理墓板の重心より上で前記第2被処理基板 の前記裏面と接触する部分を失々有することと、を特徴 とする概送装置。

【請求項3】 各底接触面は、前記鐵送方向に沿って分割 された複数の部分からなることを特徴とする請求項1ま たは2に記載の搬送装置。

【請求項4】多角形板状の接処理基板を処理するための 10 真空処理システムであって、

請求項1乃至3のいずれかに記載の搬送装置を前記被処 理体を支持した状態で収容可能な台車室と、

前記台車室に対して第1及び第2ゲート弁を介して夫々 接続された第1及び第2真空処理室と、を具備し、前記 彼処理基板は、前記銭送装置により、前記第1真空処理 室から前記台事室に鍛入され、また、前記台車室から前 記第2真空処理室に鍛入されることを特徴とする真空処 選システム。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は多角形板状の核処理 基板を取扱うための鍛送装置及び真空処理システムに関 し、例えば、矩形板状のガラス基板の表面に対して、ブ ラズマを用いて、CVD (Chemical Vapo Deposition)、スパッタリング、ドライ エッチング等のプラズマ処理を施すための真空処理シス テム内において、彼処理墓板を鍛送するための搬送装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、CVD、スパッタリング、ドライ エッチング等のプラズマ処理を施すための真空処理シス テム内において、ガラス基板等の彼処理基板を真空処理 室に対して出し入れを行なう場合、基板を基板ホルダ (トレイ)に固定し、該ホルダを基板と一緒に搬送する 方法。即ち「トレイ基板搬送方式」が一般的に採用され ている。

【①①①3】図1は従来のプラズマ処理装置を示す斜視 図である。

【10004】図1図示の如く、このプラズマ処理は、基 基板の歓送方向において互いに独立した第1及び第2支 40 板Sを処理するための処理室を形成する真空容器11を 有する。真空容器11の開閉自在の扉12には電極13 が配設される。真空容器 1 1 内に単数若しくは複数の基 板Sを収容するため、基板ホルダ (トレイ) 15 が使用 される。ホルダ15は基板Sを取付けた状態で、真空容 器11内の上部に配設された基板鍛送部材16に吊り下 けられる。真空容器 1 1 の中央には基板Sを加熱するた めのヒータ17が配設される。

【0005】墓板S及びホルダ15は、移動装置(図示 せず)によって搬送部材16と共に移動される。搬送部 前記第1及び第2裏接絵面は、前記第1被処理基板の重 50 材16に吊り下げられたホルダ15がヒータ17と電極 (3)

13との間へ移動され、ことに停止配置される。この状態で、基板Sの表面に対してプラズマ処理が施される。 【0006】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術に係る撤送方法においては、ホルダ15に基板Sを取付けるのに手間が掛かり、自動化するためには非常に復雑なロボットが必要になる。また、基板Sとして、例えばガラス基板を真空中で加熱する場合、ホルダ15も一緒に加熱するととになる。ホルダ15の加熱は、搬送系のトラブルの原因になるばかりか、ガラス基板が割れる原因となる。特に大面積被処理基板はホルダとの熱膨張差で割れるすい。更に、ガラス基板のみを加熱及び冷却する場合に比べて、ホルダ15に取付けて加熱等を行なう場合は長い処理時間を要する。

【0007】また、基板Sのホルダ15を真空容器11 内で移動させるため、ホルダ15に付着した不純物の混 入やホルダ駆動部分からの異物落下により不純物汚染が 生じる可能性がある。また、基板Sの処理後に、ホルダ 15を出口から入口へ戻さなければならないという問題 もある。

【0008】本発明はかかる従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、この種の基板の真空処理システムにおいて、基板を処理する際に保持するための従来の処理用ホルダが不要となる基板の鍛送装置を提供することを目的とする。

【0009】本発明はまた、板厚の薄い大面積級処理基板でも割れが極めて少なく、真空容器内への不純物の復入が少なく、且つ基板の加熱及び冷却に要する時間の短縮を図ることが可能な鍛送装置を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の視点は、 多角形板状の接処理基板を処理するための真空処理シス テム内において前記彼処理基板を鍛送するための搬送装 置であって、前記システム内を走行するための台車と、 前記核処理基板を支持するため、前記台車上に配設され た支持機構と、を具備し、前記支持機構は、前記被処理 基板が垂線に対して7. 乃至12. の角度で傾斜するよ うに、前記被処理基板を支持することと、前記支持機構 は、前記被処理基板の底端面に接触するための底接触面 と、前記被処理基板の裏面に接触するための第1及び第 2裏接触面とを有することと、前記第1及び第2裏接触 面は、前記被処理基板の搬送方向において互いに独立し た第1及び第2支柱に支持された第1及び第2パッド上 に夫々形成されることと、前記第1及び第2裏接触面 は、前記鍛送方向における前記彼処理基板の両端部に沿 って夫々配置されることと、前記第1及び第2裏接触面 は、前記敘処理基板の重心より上で前記敘処理基板の前 記裏面と接触する部分を夫々有することと、を特徴とす る.

【0011】本発明の第2の視点は、多角形板状の第1 及び第2被処理基板を処理するための真空処理システム 内において前記第1及び第2彼処理墓板を同時に搬送す るための銀送装置であって、前記システム内を走行する ための台車と、前記第1及び第2被処理基板を同時に支 持するため、前記台車上に配設された支持機構と、を具 償し、前記支持機構は、前記第1及び第2被処理基板が 量線に対して?、乃至12、の角度で互いに反対側に額 斜するように、前記第1及び第2被処理基板を支持する 10 ととと、前記支持機構は、前記第1被処理基板の底端面 に接触するための第1底接触面と、前記第1被処理基板 の裏面に接触するための第1及び第2裏接触面とを有す ると共に、前記第2被処理基板の底端面に接触するため の第2底接触面と、前記第2被処理基板の裏面に接触す るための第3及び第4裏接触面とを有することと、前記 第1及び第2裏接触面は、前記第1及び第2被処理基板 の搬送方向において互いに独立した第1及び第2支柱に 支持された第1及び第2パッド上に夫々形成されると共 に、前記第3及び第4桌接触面は、前記搬送方向におい 20 て互いに独立した第3及び第4支柱に支持された第3及 び第4パッド上に失々形成されることと、前記第1及び 第2裏接触面は、前記銀送方向における前記第1接処理 基板の両端部に沿って失々配置されると共に、前記第3 及び第4裏接触面は、前記搬送方向における前記第2被 処理基板の両端部に沿って夫々配置されることと、前記 第1及び第2裏接触面は、前記第1被処理基板の重心よ り上で前記第1被処理基板の前記裏面と接触する部分を 夫々有すると共に、前記第3及び第4裏接触面は、前記 第2後処理基板の重心より上で前記第2彼処理墓板の前 30 記裏面と接触する部分を夫々有することと、を特徴とす

【0012】本発明の第3の視点は、第1または第2の 視点の鍛送装置において、各底接触面は、前記機送方向 に沿って分割された複数の部分からなることを特徴とす る。

[0013]本発明の第4の視点は、多角形板状の紋処理基板を処理するための真空処理システムであって、第1乃至第3の視点のいずれかの搬送装置を前記候処理体を支持した状態で収容可能な台車室と、前記台車室に対40 して第1及び第2点空処理室と、を具備し、前記被処理基板は、前記搬送装置により、前記第1真空処理室から前記台車室に搬入され、また、前記台車室から前記第2真空処理室に搬入されることを特徴とする。

[0014]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行
50 う。

(4)

【()()15] 図2は本発明の実施の形態に係る搬送装置 2 () を示す (a) 斜視図。(b) 側面図、及び (c) 正 面図である。

【0016】図2図示の如く、鍛送装置20は、2枚の 同一寸法の矩形のガラス基板S1、S2を同時に支持 し、例えば図5を参照して後述するような、真空プラズ マ処理システム内を鍛送するように構成される。このた め、搬送装置20は、システム内を走行するための台車 21と、2枚の基板S1、S2を同時に支持するため、 台事21上に配設された支持機構22と、を有する。 【()() 17】台車2 1は、例えば、図2 (a) 図示の如 く、システム内、即ち台車室や真空処理室内の床面上に 敷設されたレール29またはガイドローラ(図2におい てはレールを図示) に沿って移動される。この場合、例 えば、台車21の側面にラックを取り付けると共に、台 直室や真空処理室の床面にビニオンドライバを配設し、 ラックとピニオンとの嚙合により、台車21を駆動する ことができる。これにより、台車21の駆動部は台車2 1の下部となるため、上部からの異物の落下がなくな り、不純物汚染による基板の品質低下が抑制される。 【0018】支持機構22は、鍛送方向D1に沿った台 車21の中心軸を挟んで、2枚の基板S1、S2が垂線 に対して約10°の角度31で互いに反対側に傾斜する よろに、2枚の墓板S1、S2を支持する。また、後述 するように、支持機構22は、各基板S1、S2の重心 より上でその裏面を接触支持する部分を有する。とのよ うな構成の結果、基板S1、S2は、機械的固定を必要 とせず、自重により安定した状態で支持機構22上に保 持される。

【()()19】なお、基板S1、S2の傾斜角度θ1は、 それらの重心と支持位置との関係で決まる。即ち、基板 S1、S2の傾斜角度 θ 1が浅いと(<7)、 搬送時 に生じた緩動等で基板S1. S2の保持の安定性を失い やすい。逆に、 $豊板S1、<math>S2の傾斜角度<math>\theta$ 1が深いと (12°く) 真型容器のデッドスペース増加と真型容 器間に設置されるゲート弁の大型化とを招き、全体装置 としてデメリットとなる。このような額点から、墓板S 1. S2の傾斜角度 € 1 は7°~12°の範囲に設定さ

【0020】支持機機22は、より具体的には、台車2 1上に垂直に固定された互いに独立する同一形状の2つ のV字型のフレーム23a. 23bを有する。2つのV 字型のフレーム23 a、23 bは、台車21の両端部近 傍に夫々配置され、両者間の間隔は、墓板S1、S2の 長さより役分小さくなるように設定される。

【0021】各フレーム23a、23bのV字型は、鐵 送方向D1に沿った台車21の中心軸に対して左右対称 となるように配設された2本の支柱241、241によ り形成される。支柱24 f. 24 rは、夫々量線に対し で夫々7°~12°、望ましくは約10°の角度∂1を 50 【0029】図2及び図3図示の鍛送鉄置20.30に

なし、従って、2本の支柱24 f、24 f間の角度はそ の倍となる。2つのフレーム23a、23bの左側の支 柱241の対により基板S1が支持され、右側の支柱2 4 r の対により墓板S 2 が支持される。

【1)022】4つの支柱241、241の夫ャの内面の 下側には、段部25が形成される。全ての段部25は同 じ高さに配置され、基板S1、S2の底端面に接触する ための底接触面を規定する。

[0023] 4つの支柱241、24rの矢ャの上側及 10 び中間には、墓板S1、S2に接触するパッドとして機 能する上側架26及び中間梁27が付設される。上側架 26及び中間緊27は、全て、支柱24g、24gから 銀送方向D1に沿って外側に水平に延在する。上側築2 6及び中間架27の内面は、支柱241、241の内面 より幾分突出し、基板S1、S2の裏面に接触するため の裏接触面を規定する。なお、彼処理基板のサイズ、板 厚にもよるが、各中間梁27を省略して上側梁26のみ とすることもできる。

【0024】上側梁26及び中間架27の内面により規 20 定される哀接触面は、鍛送方向D1における基板S1、 S2の両端部に沿って配置される。また、上側梁26の 内面により規定される裏接触面の上縁部は、基級S1、 S2の重心より上で基板S1、S2の裏面と接触するよ うに配置される。

[10025] 図3は本発明の別の実施の形態に係る鍛送 装置30を示す斜視図である。

【0026】図3図示の如く、鍛送装置30は、1枚の 矩形のガラス墓板S2のみを支持し、例えば図5を参照 して後述するような、真空プラズマ処理システム内を鍛 3G 送するように構成される。このため、搬送装置30は、 システム内を走行するための図2図示の実施の形態と同 一の台車21と、1枚の基板S2を支持するため、台車 21上に配設された支持機構32と、を有する。

【0027】支持機構32は、基板S2が垂線に対して 7°~12°、望ましくは約10°の角度で傾斜するよ ろに、基板S2を支持する。また、支持機構32は、基 板S2の重心より上でその裏面を接触支持する部分を有 する。このような構成の結果、基板S2は、磯絨的固定 を必要とせず。自重により安定した状態で支持機構32 40 上に保持される。

【0028】支持機構32は、より具体的には、図2図 示のV字型のフレーム23a、23bと同じ位置に配設 されたフレーム33 a、33 bを有する。各フレーム3 3a、33bは、一本の支柱24mのみを育し、これ は、図2図示の右側の支柱24mと同一配置で同一形状 を有する。即ち、支柱24 r は、基板52の底端面に接 触するための底接触面を規定する段部25と、基板S2 の裏面に接触するための裏接触面を規定する上側梁26 及び中間築27とを有する。

おいては、各基板S1、S2を支持するための支往24 f、24 f が7°~12°の角度で傾斜されると共に、 支柱24 f、24 f に、各基板S1、S2の重心より上 でその裏面を接触支持する部分が形成される。これにより、基板S1、S2は、拘束されることなく自重により 安定した状態で支柱24 f、24 r 上に保持される。基板S1、S2は、銀送装置20、30により真空処理室 内へ搬送することができ、図1図示のホルダ15は不要 となる。しかも、銀送装置20、30は、ホルダ15が 引起とす諸問題(基板セット用の複雑なロボット、加熱 冷却速度低下、基板割れ、不純物汚染)を伴うことがな し

【① 0 3 0 】また、各基板S1、S2は、鍛送方向D1において互いに独立した支柱241.24mの対により、非何承状態で支持される。これにより、各基板S1、S2、台車21、支持機構22.32等の熱膨張により、基板支持部分に変形が生じても、基板S1、S2を拘束する過剰な応力が発生しないため、基板S1、S2の割れを防止できる。即ち、大型で厚さの薄い基板を取扱う場合でも、或いは基板に複雑な反り等の形状変化 20が発生する場合でも、基板を破損することなく安定した状態で鍛送することができる。

【①①31】また、台章21は、その移動手段の一例として、システム内の床面上に敷設された、ラック/ピニオン機構を利用したレール29またはガイドローラに沿って移動させるととができる。これにより、台車21の駆動部からの異物の落下がなくなり、不純物汚染による基板S1、S2の品質低下が抑制される。

【① 032】図4(a)、(b)は、本発明の更に別の 実施の形態に係る鍛送装置40、50を美々示す斜視図 である。これらの鍛送装置40、50は、大型で厚さの 薄い基板でも安定した状態で鍛送することができる構造 を有する。

【0033】本発明が対象とする彼処理基板の典型的な例であるガラス基板は、サイズが大型になるほど、また厚さが薄くなるほど、基板のたわみが大きくなり、その安定した支持方法が難しくなる。

【① 0 3 4 】例えば、4 0 0×5 0 0 mmサイズ、厚さ 1. 1 mmの基板では水平設置基板たわみが2. 9 mm 程度でしかないものが、同サイズ、厚さ 0. 7 mmの基 40 板では 1 0. 4 mm と大きくなる。また、5 5 0×6 5 0 mmサイズ、厚さ 1. 1 mmの基板では水平設置基板 たわみが6. 6 mm程度と大きくなり、同サイズ、厚さ 0. 7 mmでは 2 0. 3 mm と 更に大きくなる。これら の基板は本発明に従って約 1 0 で傾斜させることで、た わみ量を 1 / 6以下にすることが可能となり、基板の保持安定性が確保できる。しかし、更に大型で厚さの薄い 基板を使用する場合、本発明による斜め支持でも、基板 のたわみがその安定保持に意影響を及ぼし始めることに なる。 50

【0035】とのため、図4(a)図示の飲送装置40においては、図2図示の搬送装置20に対して、更に、基板S1、S2の中間部分を支持するための中間フレーム41が追加される。中間フレーム41は、両側の2つのV字型のフレーム23a 23bの略中間位置で、台車21上に固定される。

板 S 1 、 S 2 は、継送装置 2 0 、 3 0 により真空処理室内へ接送するととができ、図 1 図示のホルダ 1 5 は不要となる。しかも、搬送装置 2 0 、 3 0 は、ホルダ 1 5 が る 2 つの短い中間支柱 4 2 f 、 4 2 r を 有する。中間支持 4 2 f 、 4 2 r を 有する。中間支持 4 2 f 、 4 2 r を 有する。中間支持 4 2 f 、 4 2 r を 有する。中間支持 4 2 f 、 4 2 r の 大の内面の下側には、股部 4 3 が 形成される。段部 4 3 は両側の支柱 2 4 f 、 2 4 r に 形成される。段部 4 3 は両側の支柱 2 4 f 、 2 4 r に 形成された 段部 2 5 と同じ高さに配置され、基板 S 1 、 S 2 の中間部の底端面に接触するための底接触面を規定する。

【0037】また、図4(b)図示の撥送装置50においては、図3図示の鍛送装置30に対して、更に、基板S2の中間部分を支持するための中間フレーム51が追加される。中間フレーム51は、両側の2つのフレーム33a、33bの略中間位置で、台車21上に固定される。

【0038】中間フレーム51は、フレーム33a、33bの支柱24rと同じ角度で領斜する短い中間支柱42rを有する。中間支柱42rの内面の下側には、段部43が形成される。段部43は外側の支柱24rに形成された段部25と同じ高さに配置され、基板S2の中間部の底線面に接触するための底接触面を規定する。

【0039】図4(a).(b)図示の搬送装置40、50によれば、芸板S1、S2の中間部分を支持するための中間フレーム41、51を追加することにより、基板S1、S2のたわみによる影響を接送に問題のないレベルに減らすことができる。なお、図示の例においては、中間フレーム41、51を1つだけ配設しているが、更に基板が大型化してそのたわみが大きい場合は、中間フレーム41、51を複数個配設することにより、基板のたわみを更に減少させることができる。

【0040】図5は、本発明の実施の形態に係る真空プラズマ処理システム60の平面レイアウトを機略的に示す図であり、ことでは、一例として、複数の真空処理室を直列に配置した構成を示す。処理システム60において、彼処理基板であるガラス基板を搬送するための撤送装置72として、図2万至図4図示の搬送装置20、30、40、50のいずれかが使用される。

【0041】図5図示の実施の形態において、処理システム60は、プラズマ成勝処理等の真空処理を行うための3つの真空処理室61を具備する。各真空処理室61において、撤送装置72により搬送されてきた核処理基板は、真空処理室61内に配設されたハンドリングアーム(図示せず)を介して華板支持部村(図示せず)上に移載される。そして、被処理基板は同華板支持部村により所定位置に保持され、この状態で被処理基板の裏面ま

たは表面に対してプラズマ処理が施される (特願平5-279497参照)。

【()()42)3つの真空処理室61を有する処理システ ム60はまた、搬送装置72を収容して待機させるよう に設計された4つの台車室62a、62b、62(2 個) を有する。各台車室62a、62b、62は、予備 真空空間を形成するためのロードロック室として構成さ れる。ここで、ロードロック室とは、窒素等の不活性ガ スの供給部材と、同室内を排気する排気部材とを有し、 不活性ガスによる内部雰囲気の遺換。減圧、加圧を独立 10 ム60に彼処理墓板を供給するために使用したカセット して行える室を意味する。従って、ロードロック室を大 気圧まで加圧した状態で核処理基板を搬送装置?2と一 緒にロードロック室内に搬入し、ロードロック室内を真 空排気の後、後途のゲート弁69を開放することによ り、真空処理室61を真空に保持したまま、彼処理基板 を搬送装置72と一緒に真空処理室61内に鍛入するこ とができる。

【① 0 4 3 】 3 つの真空処理室6 1 及び4 つの台車室6 2a. 62b. 62は、交互に且つ間にゲート弁69を 挟んで直列に接続される。最上流の台車室62a及び最 20 用の複雑なロボット、加熱冷却速度低下、基板割れ、不 下流の台車室62hは、夫々ロード室及びアンロード室 として機能する。

【①①4.4】ロード室62aの上流側には、銀送装置7 2内に彼処理基板を補込むためのロボットであるローダ 65が、ゲート弁69を介して配設される。ローダ65 は、他の処理システムとのインターフェースとして機能 するカセットステーション67に隣接して配設される。 【① 045】アンロード室625の下流には、搬送装置 72内から彼処理基板を取出すためのロボットであるア ンローダ66が、ゲート弁69を介して配設される。ア 30 ンローダ66で取出した処理済みの基板をローダ65に 戻すため、基板リターン機構63が配設される。基板リ ターン機構63でローダ65に戻された処理済みの基板 は、ローダ65でカセットケース内に収納される。カセ ットケース内に収納された処理済みの墓板は、カセット ステーション67へ戻され、必要に応じて他の処理シス テムへ鍛送される。

【①①46】図5図示の真空プラズマ処理システムによ れば、鍛送装置了2を待機させるための台車室62を処 **理室61間に配設することにより、プラズマ処理前後の 40 21…台車** 彼処理基板を搬送装置72と共に一時待機させることが. できる。このため、処理室同士が直接接続される場合に 比べ、スループット(処理速度)を向上させることがで きる。即ち、台車室62を配設することにより、ある処 理室61で処理が完了した基板を鍛送装置72により速 やかに下流の台車室62へ振出し、更に下流の処理室6 1の処理が完了次第、この搬送装置72により同台車室 62から基板を移動して次のプラズマ処理を行うとい **う,効率的な操作を行うことが可能となる。**

【0047】また、台車室62を処理室61間に配設す 50 43…段部

ることにより、処理室同士が直接接続される場合に比 ペ、隣接する処理室61間のクロスコンタミネーション を低減し、プロセスの信頼性を向上させることができ る。特に、台車室62を搬送装置72を収容可能な真空 保持室として構成すると、搬送装置72上の残留付着ガ スや処理生成物を真空中における拡散力によりある程度 除去することができる。

【①048】また基板リターン機構の採用により、処理 済み墓板のみをロードロック室側へ戻し、本処理システ ケース内に再収納することが可能となり、工場において の装置運用性が向上する。

[0049]

【発明の効果】本発明に係る微送装置によれば、接処理 基板は、拘束されることなく自重により安定した状態で 台車上に保持され、真空処理室内に搬送されることがで きる。従って、核処理基板を保持するための従来の処理 用ホルダは不要となる。しかも、本発明に係る搬送装置 は、従来の処理用ホルダが引起こす諸問題(基版セット 絶物汚染〉を伴うことがない。

【()()5()】本発明に係る真空処理システムによれば、 台車室が処理室間に配設され、ここに搬送装置を待機さ せることができる。従って、スループット(処理速度) を向上させると共に、処理室間のクロスコンタミネーシ ョンを低減し、プロセスの信頼性を向上させることがで

【図面の簡単な説明】

【図1】従来のプラズマ処理装置を示す斜視図。

【図2】本発明の実施の形態に係る搬送装置を示す

(a)斜視図。(b)側面図、及び(c)正面図。

【図3】本発明の別の実施の形態に係る鐵送装置を示す 斜視図。

【図4】本発明の更に別の実施の形態に係る鍛送装置を 夫々(a)、(b)に示す斜視図。

【図5】本発明の実施の形態に係る真空プラズマ処理シ ステムの平面レイアウトを概略的に示す図。

【符号の説明】

20,30,40,50…搬送装置

22. 32…支持機構

23a, 23b, 33a, 33b--- 7\(\bullet - \text{\ti}\text{\texi\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\\ti}\tittt{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\te

24f, 24r…支柱

25…段部

26…上側築

2 7 … 中間梁

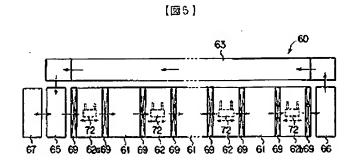
29…レール

41.51…中間フレーム

42 f、42 r…支柱

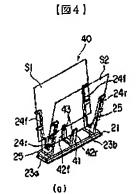
(6)

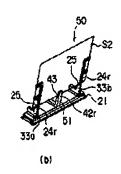
特闘2000-177842 (7) <u>11</u> 6 ()…真空処理システム *65…ローダ 66…アンローダ 61…真空処理室 62a、62b. 62…台事室 6?…カセットステーション 63…基板リターン機模 72…做送装置 [22] [図1] (e) [図3] **{b**}



(8)

特闘2000-177842





フロントページの続き

(72)発明者 上野 茂一

長崎県長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工

業株式会社長崎造船所內

(72)発明者 近蘇 敬宣

長崎県長崎市館の浦町1番1号 三菱重工 業株式会社長崎造船所內

(72)発明者 西村 利通

長崎県長崎市館の浦町1番1号 長菱設計

株式会社内

Fターム(参考) 5F031 CA05 DA01 FA09 GA58 MA29

5FG45 AA08 AF07 BB14 DP21 DQ15 EB08 EM01 EM04 HA24

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

	BLACK BORDERS
Ø	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
اً ت	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
Ø	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П	OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.